

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number : 04-000783  
 (43) Date of publication of application : 06.01.1992

(51) Int.Cl.

B01B 9/18

(21) Application number : 02-152819  
 (22) Date of filing : 13.06.1990

(71) Applicant : HITACHI LTD  
 (72) Inventor : KAYANE NAOKI  
 SAKANO SHINJI  
 OKA SATOHICO  
 UOMI KAZUHISA  
 OTOSHI SO  
 TSUCHIYA TOMONOB  
 OKAI MAKOTO

## (30) Priority

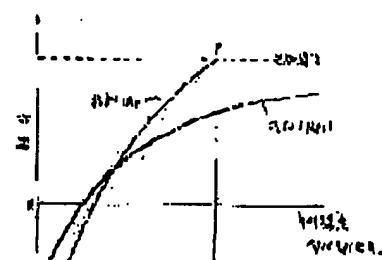
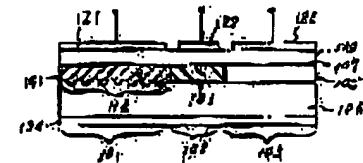
Priority number : 01149603	Priority date : 14.06.1989	Priority country : JP
01224463	01.09.1989	JP
02100306	18.04.1990	JP

## (54) SEMICONDUCTOR OPTICAL ELEMENT

## (57) Abstract:

**PURPOSE:** To stably oscillated light of a desired wavelength by differentiating the differentiation gain coefficient for an injected carrier density of a gain active layer osciilated through amplification of a light having a specific wavelength from that for a light amplifying active later.

**CONSTITUTION:** A phase regulating region 102 having an optical waveguide 181 in which a refractive index is reduced upon increasing of injected carrier density and a light amplifying region 103 made of an active optical waveguide 105 having a second active layer structure are provided. When a material having shorter wavelength of the wavelength  $\lambda_{P2}$  of a gain peak than a laser oscillation wavelength  $\lambda_L$  is used as an active waveguide 141, the wavelength  $\lambda_{P2}$  does not coincide with the wavelength  $\lambda_L$  in the material having the short wavelength  $\lambda_{P2}$  at a gain peak. Accordingly, a gain gradient becomes smooth, and even if carrier density is increased, an increase in a photon density is suppressed, a reduction in carrier density upon inductive emission depending upon the photon density is suppressed to increase the carrier density. Therefore, a region 101 does not reach a gain to self-oscillation, and a wavelength variable width and particularly Bragg's reflection



BEST AVAILABLE COPY

wavelength can be increased.

**LEGAL STATUS**

- [Date of request for examination]
- [Date of sending the examiner's decision of rejection]
- [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]
- [Date of final disposal for application]
- [Patent number]
- [Date of registration]
- [Number of appeal against examiner's decision of rejection]
- [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
- [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY

D4

⑩日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

## ⑫公開特許公報(八) 平4-783

⑬Int. Cl.

H 01 S 3/16

識別記号

序内整理番号

6940-4M

⑭公開 平成4年(1992)1月6日

審査請求 未請求 請求項の数 50 (全22頁)

⑮発明の名称 半導体光電子

⑯特 願 平2-152819

⑰出願 平2(1990)6月13日

優先権主張 ⑧平1(1989)6月14日 ⑨日本(JP) ⑩特願 平1-149603

⑪発明者 斎根 直樹 東京都国分寺市東恋ヶ窓1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内

⑫発明者 坂野 伸治 東京都国分寺市東恋ヶ窓1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内

⑬発明者 岡 慎彦 東京都国分寺市東恋ヶ窓1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内

⑭出願人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

⑮代理人 弁理士 小川 勝男 外1名

最終頁に統く

## 明細書

## 1. 発明の名称

半導体光電子

## 2. 特許請求の範囲

1. 光学的に結合しキャリアの注入により利得の変化を生じる複数の活性層を含む複数の半導体領域であって、注入されたキャリアにより光を放出するための光増幅活性層を含む増幅領域とこの光増幅活性層により放出された光を遮断するための利得活性層及び遮断する光を遮断するための分布共振構造を含むDBR構造とを有するものと、これら複数の半導体領域にキャリアを注入する手段と、上記光増幅活性層が放出する光のうち特定の波長を有する光を上記分布共振構造により選択的に遮断することにより上記特定波長を有する光を増幅して発振するための共振器構造とを有し、上記利得活性層の有する注入キャリア密度に対する微分割保険を上記光増幅活性層の有する注入キャリア密度に対する微分割保険とは異なる半導体レーザ装置

## 図

2. 請求項1に記載の半導体レーザ装置において、前記光増幅活性層を構成する半導体材料と、前記利得活性層を構成する半導体材料とは、異なる半導体材料である半導体レーザ装置。
3. 請求項1に記載の半導体レーザ装置において、前記複数の活性層は表子共用構造を有する半導体レーザ装置。
4. 請求項1に記載の半導体レーザ装置において、前記利得活性層の微分割保険が前記光増幅活性層の微分割保険より小さい半導体レーザ装置。
5. 請求項1に記載の半導体レーザ装置において、前記位相調節領域は能動的半導体材料により形成されている光を遮断するための光遮断層を有する半導体レーザ装置。
6. 請求項1に記載の半導体レーザ装置において、前記位相調節領域は前記共振器の光路長を変化させるための電極を有する半導体レーザ装置。
7. 請求項1に記載の半導体レーザ装置において、

BEST AVAILABLE COPY

## 特開平4-783(7)

領域に電波を発することにより生じる損失を補償するだけの利得をD R領域に持たせることが必要となる。従ってこの吸収損失が大きくなると、これを補償させようとする結果、D R領域が自身の利得により自己発振を起こしてしまうという根本的な問題がある。既述した位相調節領域と光増幅領域を細分化する手段も位相調節領域で発生する吸収の根本的な除去にはならない。

また、波長チャーピングを押さえた使用用レーザにおいては、波長チャーピングを低減するために、バイアス条件や光出力の選択の範囲がいとおい小さくなってしまう。この制限は更に高速特性をも拘束するという問題がある。

本発明の目的は、上記従来技術の有する技術的課題を解決し、所望の波長を安定に発振する半導体レーザ装置を提供することにある。

また、本発明の他の目的は、上記のように吸収や利得による制限を放り除き、より大きな屈折率変化層を有する半導体レーザ装置を提供することにある。

活性層の有する注入キャリア密度に対する微分利得係数を上記光増幅活性層の有する注入キャリア密度に対する微分利得係数とは異ならせた半導体レーザ装置が提供される。

本発明でいう活性層とは、利得が1より大きいことを意味する、利得が1より大きいとは、ある波長の光に対し増幅的、すなわち増幅機能が存在することを意味する（従って利得が1以下という場合には効動的、すなわち光の強度が一定のまま変化しないか、若しくは吸収されて光の損失が生じることを意味する）。本発明は、このような活性層を複数有する。

これらの活性層の、注入キャリア密度の対する微分利得係数を異ならせることが、本発明の1つの特徴である。この微分利得係数とは、注入キャリア密度の変化量に対する利得の変化量のことである。微分利得係数に差異を設けることにより、少なくとも1つの活性層においては自己発振が生じないようになることが可能となる。微分利得係数に差異を設けるためには、例えば活性層を構成

本発明の更に他の目的是、複数の活性層のうち1部の活性層へのキャリア注入による利得係数の増加を小さく抑えることにより、大きな波長可変幅が得られ、若しくは選択波長による発振出力の変化が小さい半導体レーザ装置を提供することにある。

## 【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するためには、本発明の1方面によれば、光学的に結合レーザキャリアの注入により利得の変化を生じる活性層を含む複数の半導体領域であって、注入されたキャリアにより光を放出するための光増幅活性層を含む増幅領域と二の光増幅活性層により放出された光を遮断する利得活性層及び遮断する光を遮断するための分布遮断構造を含むD R領域とを有するものと、これら複数の活性領域に中キャリアを注入する手段と、上記光増幅活性層が放出する光のうち特定の波長を有する光を上記分布遮断構造により選択的に遮断することにより上記特定波長を有する光を増幅して発振するための共振器構造とを有し、上記利

する半導体材料、若しくは活性層を構成する化合物半導体の元素組成を変えることにより、また、量子井戸構造に代換されるように活性層の厚さに変化を設けることによっても実現される。これらの変化は再結合発光する電子と正孔のエネルギー差、すなわちバンドギャップ若しくは量子井戸を形成する活性層内の電子と正孔のエネルギー状態の差に起因する。微分利得係数が小さい活性層において自己発振が押さえられるため、この活性層が形成される領域をD R領域とする。

また、本発明における複数の活性層、すなわち光増幅活性層と利得活性層は直接に、若しくは他の（受動的若しくは能動的）遮断層（利得が1以下の領域）を介して、光学的に結合する。光増幅活性層により放出された光は利得活性層内を伝播し、光増幅活性層及び利得活性層を含んで構成された共振器内部を伝播、増幅される。共振器が選択、増幅する発振波長は、実効的な共振器長を変化させることによって可変となる。共振器の実効的な長さ、すなわち光路長は、共振器端面間の距

BEST AVAILABLE COPY

## 特開平4-783 (B)

題、若しくは前面と後述する分布場選択層との距離が、共振器内を往復する光の位相条件を満足するように設定する必要があるため、上記導波層の屈折率を可変とすると良い。このような位相調節のための領域は、例えばこの領域に独立にキャリアを注入することができるよう電極が設けられる。また、必ずしも光増幅活性層及び利得活性層の間に設けられていないくとも良く、上記共振器構造内において光が伝播する領域に設けられていれば良い。

半導体レーザの共振波長の設定は、共振器内の屈折率を一部領域において変化させることにより行うが、この一部領域は光が分布する領域内に設けられた分布場選択層の場合がある。分布場選択層は一般にはグレーティングを形成した半導体上に異なる屈折率を有する半導体を積層したもので、屈折率の周囲的分布を形成したものである。

また、本発明の他の1局面によれば、異なる利得ピーク波長を有する複数の活性層と、これらの利得ピーク波長とは異なる特定の波長を有する光

を選択的に選択することにより上記特定波長を有する光を増幅して発振するための共振器とを有する半導体レーザ装置が開示される。発振波長を、活性層の利得を最大にする波長（利得のピーク波長）からずらして設定することに本発明の1つの特徴がある。

本発明の更に他の1局面によれば、光学的に組合しキャリアの注入により利得の変化を生じる複数の活性層を含む複数の活性領域と、これら複数の活性領域にキャリアを注入する手段と、上記活性層が放出する光のうち特定の波長を有する光を選択的に選択することにより上記特定波長を有する光を増幅して発振するための共振器構造とを有し、上記利得活性層及び上記活性層がキャリア因式変動に基づく屈折率の変動を相互に補償するようにした半導体レーザ装置が提供される。

相互に補償するためには、上記複数の活性層として利得のピーク波長が異なるものを用いる。これらのピーク波長の間に発振波長を設定することにより、キャリアの密度変動に伴う活性層の屈折

率変化を上記複数の活性層間で相互に相殺して位置チャーピングを低減することが可能となる。

上記いずれの場合も、複数の活性層のうち少なくとも一つの活性層が回折格子（分布場選択層）の近傍に配置されていることにより、回折格子部分の損失の発生を防ぐことができる。特に「近傍に配置されている」とは、その活性層と回折格子が並行に異なるように配置されていることを意味する。

また、本発明の更に他の1局面によれば、D B R領域へのキャリア注入による利得の増加を小さく抑えるために、利得ピーク波長が共振波長より短波長側にある材料を、このD B R領域を構成する活性層に用いた半導体レーザ装置が提供される。

## 〔作用〕

まず、本発明の原理の1つを図面を用いて説明する。本発明を波長可変レーザとして構成したものを第1図に、更にこの中に用いられている活性層のキャリア密度に対する利得と屈折率変化を第3A図及び第3B図に示し。これらを用いて説明

する。

この半導体レーザは、基板106上に設けられた回折格子112に接するように形成された第1の活性層を持つ活性光導波路141からなる分布プラグ反射（D B R）基板101。受動的な材料で構成され、注入キャリア密度の増加に伴い屈折率が減少する光導波路181を有する位相調節層102、第2の活性層複数を有する活性光導波路105からなる光増幅層103からなり。各々の3領域は、L型の基板106とT型のクラッド層107ではされた例えはL-T-L接合で構成されると同時にクラッド層107上に形成された独立した電極121、122、123を有し、また前記電極と活性層を反する共通の電極124を有する。

レーザ発振は、D B R領域101の回折格子による反射と光増幅層103側の端面120からの反射で共振器を形成し、光増幅層103に電極123を介して電波注入したとき生ずる大きな利得により行われる。共振波長を決定するのは、

特開平4-783(日)

DBR領域101のプラグ反射波長領域内の波長であると同時に共振器内で1往復する位相が2πの整数倍を満たす波長である。

さて記述した特開昭64-48283号公報に記載の例では、この1図に対応させて説明すると、DBR領域101の活性遮断路141に注入電流に対し利得の大きい光増幅領域103の活性光導波路105を用いていた。このときのキャリア密度と利得、及び屈折率変化の関係を2A図及び2B図に示す。活性材料の利得ピーク波長λ<sub>1</sub>はレーザ発振波長λ<sub>2</sub>に一致するように設定する。このため、レーザ発振波長λ<sub>2</sub>におけるキャリア注入に対する利得は急激に増加する。従って、DBR領域1は自己発振し、すなわち、分布共振型(DFB)レーザのように動作する。その結果、2A図の点Dでキャリア密度が固定されて、屈折率変化が制限を受けることになる(2B)。

これに対し、DBR領域101の活性光導波路141に光増幅領域103の活性遮断路105とは注入キャリア密度に対する利得変化(部分利得

係数)が異なる活性層を用いると、自己発振による屈折率変化の制限を受けず、しかも、運動的な位相調節領域102で発生する損失を補うことができる。これにより光増幅領域の発振しない遮断路を増大させることなく、広い波長可変幅が同時に得られることになる。例えば、その構成として、利得ピークの波長λ<sub>1</sub>がレーザ発振波長λ<sub>2</sub>よりも短波長にある材料を活性遮断路141に用いる。この材料を用いた光導波路のキャリア密度と利得及び屈折率変化の関係を同じく第2A図及び第2B図に示す。利得ピークが短波長λ<sub>1</sub>の材料で~~注入電流~~  
~~はレーザ発振波長λ<sub>2</sub>~~一致しないため、利得勾配がゆるやかになる。このため、キャリア密度を増大(注入電流を増大)させても、キャリア密度の増大とともに光子密度の増加が抑えられ、更に光子密度に依存する崩壊放出に付随するキャリア密度の減少が抑えられてキャリア密度の増大が得られる。従って、DBR領域101が自己発振するだけの利得に達しない。このため、屈折率変化を生じさせるキャリア密度

が固定されず、有効に利用できる。さて、キャリア密度の変化による屈折率の変化は、波長に対して緩やかにして変化しないため、利得ピークが短波長にある材料のレーザ発振波長λ<sub>2</sub>におけるキャリア密度の変化による屈折率変化は、利得ピークにある第1の活性層よりは多少劣るが、同程度の値をとる。このため、波長可変幅、特にプラグ反射波長の可変幅を大きくとることができるようになる。

上記のように、DFB領域に光増幅領域よりもキャリア密度に対する利得を少なくすることにより、光増幅領域の発振しない遮断路の増大を抑えながら広い波長可変性を持てることができる。

位相調節に関しては、位相調節領域102へ電流注入を行ない、プラグ反射端とヘミ開閉面120間のレーザ光の鏡モード共振器に位相を合わせることにより、広い波長範囲にわたり单一モード状態で逐次的に発振波長をシフトさせることができとなる。また、注入キャリア密度の変化による利得変化が平坦化するので、発振波長をシ

トさせた時の発振出力の変化が低減するという効果がある。

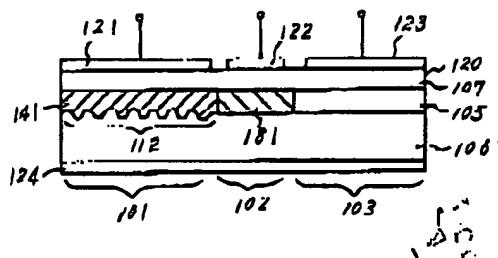
さらに、光増幅領域103を構成する活性な光導波路105の材料として、発振時の利得ピーク波長が発振波長より長いものを用いることにより、発振波長を利得ピーク波長より短波長波に配置することができる。この駆動により、キャリア密度のゆらぎに伴う屈折率の変化と利得の変化の比、いわゆる $\beta$ パラメータが小さくなるため、スペクトル品質が小さくなる。

第3図により、本発明の別の原理を説明する。図中、第1図と同一符号のものは、同一構成を表す(以下、各図間ににおいて同様)。本構成は第1図のDFB領域と位相調節領域の光導波路構造を入れ替えて、DBR領域101に受動的でキャリアを注入すると屈折率が減少する光導波路382を用い、位相調節領域102に第2の活性光導波路342を用いる。これにより、駆動、受動的な位相調節領域で生じていたキャリアの増加に伴う吸収損失の増大を防ぐことが出来る。但

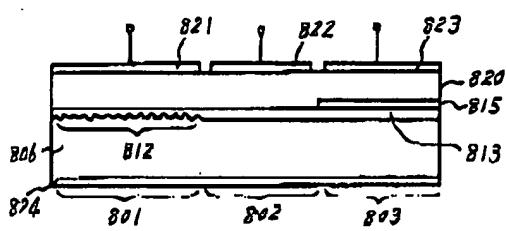
BEST AVAILABLE COPY

特開平4-783 (18)

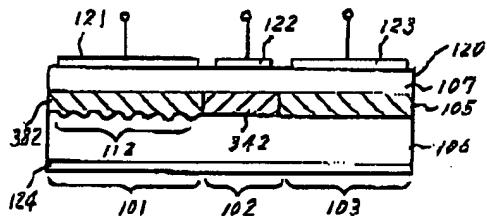
第 1 図



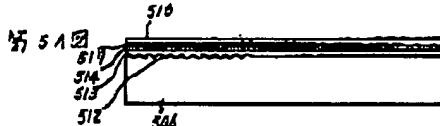
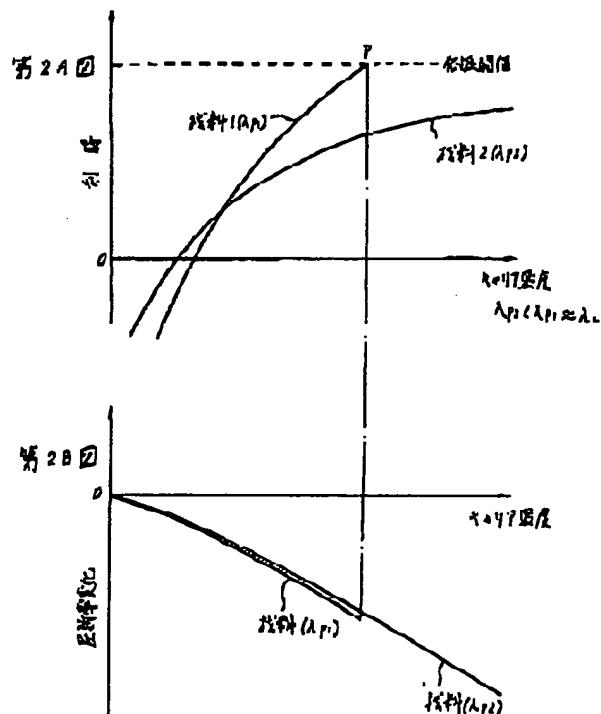
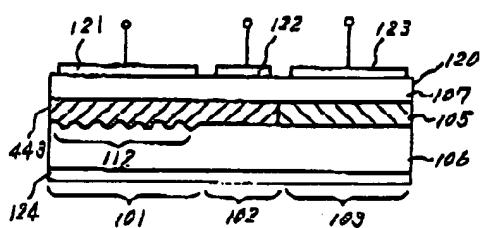
第 8 図



第 3 図



第 4 図



BEST AVAILABLE COPY